

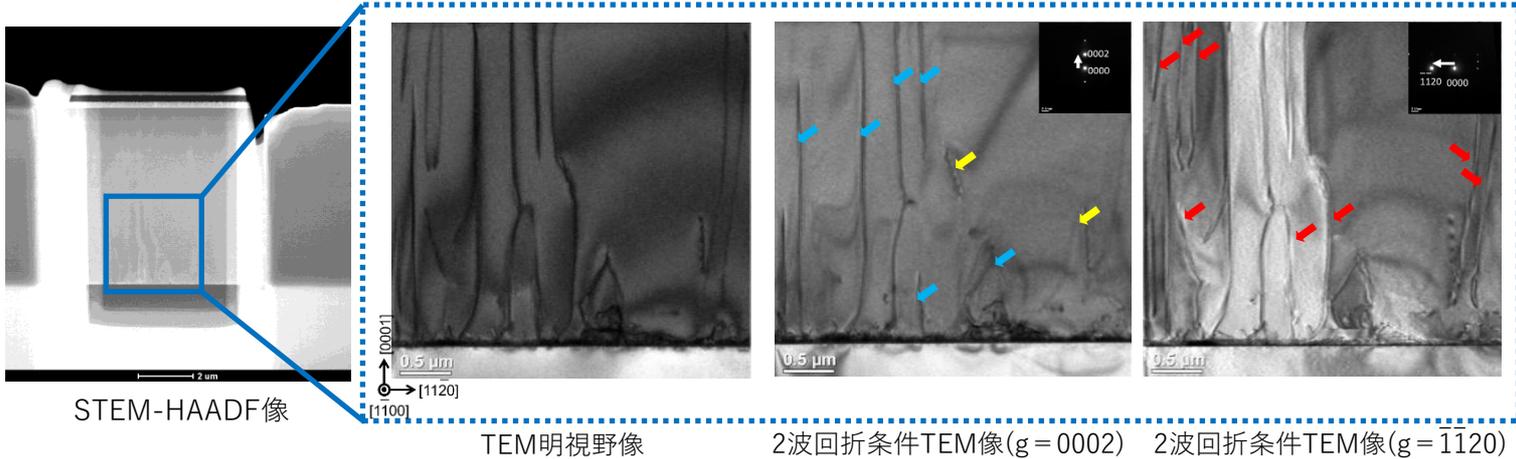
## GaN LEDのTEMによる微細構造評価

GaN LEDはサファイヤなどの基板の上に作製されますが、格子定数の不整合により転位が発生します。この転位の種類と密度をTEMにより評価しました。また、発光の中心であるMQW構造をTEMとEDXにより評価しました。

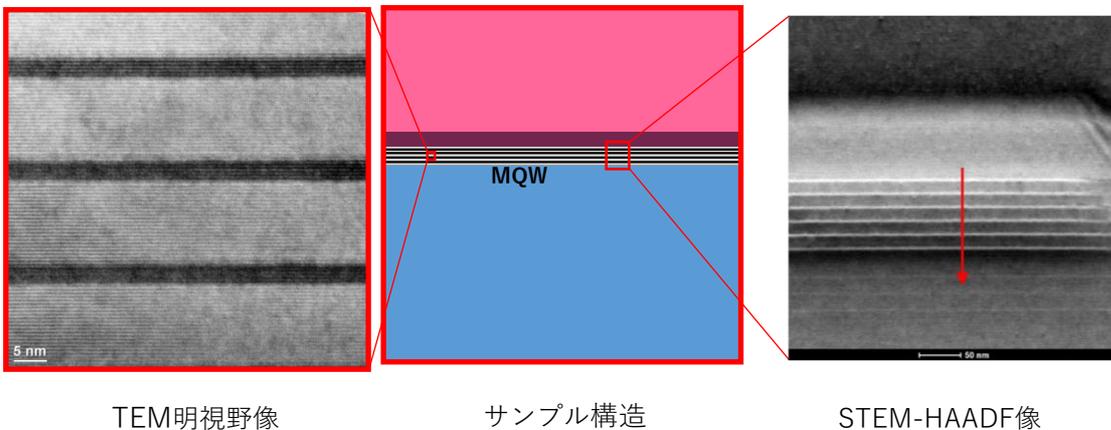
### GaN中の転位評価

転位の種類は2波回折条件で観察したTEM像のコントラストの強弱により決定します。転位の密度はHamの方法により算出します。(右表が算出結果)

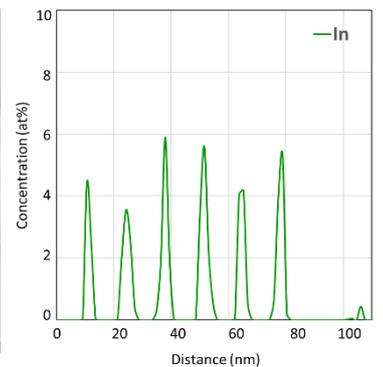
転位の種類	転位密度(1/cm <sup>2</sup> )
刃状転位(赤)	6.8E+8
螺旋状転位(黄)	4.9E+7
混合転位(青)	6.6E+8
合計	1.4E+9



### MQW構造の格子像観察



### MQW構造のIn濃度プロファイル



お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

<https://iontc.co.jp/contact>

